

Spezifikationen	
Artikelnummer	DMT6008LFG-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 13A PWDI3333-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2686 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250μA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerDI3333-8
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.5 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	2.2W (Ta), 41W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerWDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2713pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	50.4nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13A (Ta), 60A (Tc)

sein:

DMT6008LFG-7
Diodes Incorporated
MOSFET N-CH 60V 13A
PWDI3333-8



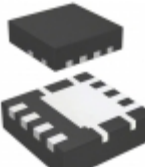
DMT6007LFG-13
Diodes Incorporated
MOSFET BVDSS: 41V 60V
POWERDI333



DMT6007LFG-7
 Diodes Incorporated
 MOSFET BVDSS: 41V 60V
 POWERDI1333



DMT6009LFG-7
Diodes Incorporated
MOSFET N-CH 60V 11A



DMT6009LFG-13
Diodes Incorporated
MOSFET N-CH 60V 11A
POWERDI3333-

DIODES
SEMICONDUCTORS

PERICOM POWER
ANALOG DATA CONVERTERS

DMT6008LFG
DIODES
DMT6008LFG DIODES

DIODES
SEMICONDUCTORS

PERICOM POWER MANAGEMENT
ANALOG POWER MANAGEMENT

DMT6009LFG
DIODES
DMT6009LFG DIODES

Mehr

Schlüsselwort				
Diodes Incorporated	DMT6008LFG-13 Datenblatt	DMT6008LFG-13-Datenblätter	DMT6008LFG-13 PDF	Diodes Incorporated DMT6008LFG-13
DMT6008LFG-13 Electronic	DMT6008LFG-13-Komponenten	DMT6008LFG-13-Verteiler	DMT6008LFG-13-Bild	DMT6008LFG-13-Teil
DMT6008LFG-13 Preis	DMT6008LFG-13 Hersteller	DMT6008LFG-13 Bild	DMT6008LFG-13 Aktie	DMT6008LFG-13 Inventar
DMT6008LFG-13 Neu	DMT6008LFG-13 Original	DMT6008LFG-13 garantiert	DMT6008LFG-13 RFQ	DMT6008LFG-13 Online bestellen